

[Search Forms](#)[Search Results](#)[Help](#)[User Searches](#)[Clear >](#)[Generate Collection](#)[Print](#)[Fwd Refs](#)[Bkwd Refs](#)[Preferences](#)[Generate OACS](#)[Logout](#)

Hit List

Search Results - Record(s) 1 through 11 of 11 returned.

1. Document ID: US 20030234404 A1

Using default format because multiple data bases are involved.

L5: Entry 1 of 11

File: PGPB

Dec 25, 2003

PGPUB-DOCUMENT-NUMBER: 20030234404

PGPUB-FILING-TYPE: new

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 20030234404 A1

TITLE: Semiconductor light-emitting device

PUBLICATION-DATE: December 25, 2003

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	CITY	STATE	COUNTRY	RULE-47
Matsuoka, Takashi	Kanagawa		JP	
Okamoto, Hiroshi	Kanagawa		JP	

US-CL-CURRENT: 257/103; 257/88, 257/90, 257/94

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Sequences](#) | [Attachments](#) | [Claims](#) | [KMIC](#) | [Drawn D](#)

2. Document ID: US 6709881 B2

L5: Entry 2 of 11

File: USPT

Mar 23, 2004

US-PAT-NO: 6709881

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 6709881 B2

TITLE: Method for manufacturing semiconductor and method for manufacturing semiconductor device

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Sequences](#) | [Attachments](#) | [Claims](#) | [KMIC](#) | [Drawn D](#)

3. Document ID: US 6642546 B2

L5: Entry 3 of 11

File: USPT

Nov 4, 2003

US-PAT-NO: 6642546

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 6642546 B2

1 TITLE: Nitride based semiconductor device and method of forming the same

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Sequences](#) | [Attachments](#) | [Claims](#) | [KMC](#) | [Drawn De](#)

4. Document ID: US 6610144 B2

L5: Entry 4 of 11

File: USPT

Aug 26, 2003

US-PAT-NO: 6610144

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 6610144 B2

** See image for Certificate of Correction **

TITLE: Method to reduce the dislocation density in group III-nitride films

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Sequences](#) | [Attachments](#) | [Claims](#) | [KMC](#) | [Drawn De](#)

5. Document ID: US 6586762 B2

L5: Entry 5 of 11

File: USPT

Jul 1, 2003

US-PAT-NO: 6586762

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 6586762 B2

TITLE: Nitride semiconductor device with improved lifetime and high output power

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Sequences](#) | [Attachments](#) | [Claims](#) | [KMC](#) | [Drawn De](#)

6. Document ID: US 6558995 B1

L5: Entry 6 of 11

File: USPT

May 6, 2003

US-PAT-NO: 6558995

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 6558995 B1

TITLE: Holographic, laser-induced fabrication of indium nitride quantum wires and quantum dots

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Sequences](#) | [Attachments](#) | [Claims](#) | [KMC](#) | [Drawn De](#)

7. Document ID: US 6555403 B1

L5: Entry 7 of 11

File: USPT

Apr 29, 2003

US-PAT-NO: 6555403

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 6555403 B1

TITLE: Semiconductor laser, semiconductor light emitting device, and methods of manufacturing the same

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Sequences](#) | [Attachments](#) | [Claims](#) | [KMC](#) | [Draw. D](#)

8. Document ID: US 6495852 B1

L5: Entry 8 of 11

File: USPT

Dec 17, 2002

US-PAT-NO: 6495852

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 6495852 B1

TITLE: Gallium nitride group compound semiconductor photodetector

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Sequences](#) | [Attachments](#) | [Claims](#) | [KMC](#) | [Draw. D](#)

9. Document ID: US 6346431 B1

L5: Entry 9 of 11

File: USPT

Feb 12, 2002

US-PAT-NO: 6346431

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 6346431 B1

TITLE: Quantum dot infrared detection device and method for fabricating the same

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Sequences](#) | [Attachments](#) | [Claims](#) | [KMC](#) | [Draw. D](#)

10. Document ID: US 6153894 A

L5: Entry 10 of 11

File: USPT

Nov 28, 2000

US-PAT-NO: 6153894

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 6153894 A

TITLE: Group-III nitride semiconductor light-emitting device

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Sequences](#) | [Attachments](#) | [Claims](#) | [KMC](#) | [Draw. D](#)

11. Document ID: US 5959307 A

L5: Entry 11 of 11

File: USPT

Sep 28, 1999

US-PAT-NO: 5959307

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 5959307 A

TITLE: Nitride semiconductor device

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Sequences](#) | [Attachments](#) | [Claims](#) | [KMC](#) | [Draw. D](#)

[Clear](#)

[Generate Collection](#)

[Print](#)

[Fwd Refs](#)

[Bkwd Refs](#)

[Generate OACS](#)

WEST Search History

DATE: Thursday, June 24, 2004

<u>Hide?</u>	<u>Set Name</u>	<u>Query</u>	<u>Hit Count</u>
<i>DB=PGPB,USPT,EPAB,JPAB,DWPI,TDBD; PLUR=YES; OP=OR</i>			
<input type="checkbox"/>	L7	L6l4 and l6	0
<input type="checkbox"/>	L6	l2 adj l1 adj n	183
<input type="checkbox"/>	L5	L4 and l3	11
<input type="checkbox"/>	L4	quantum adj dot\$	2646
<input type="checkbox"/>	L3	l1 adj l2 adj N	359
<input type="checkbox"/>	L2	ga?sub.\$	11765
<input type="checkbox"/>	L1	in?sub.\$	14810

END OF SEARCH HISTORY